
Lotus Deep Reactive Ion Etching

نانوحسگرهای هوشمند لوتوس

Tel ۰۲۱-۶۶۹۰۲۳۰۸

Email info@imns.ir

تهران- بزرگراه چمران- خیابان باقرخان-

مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)- مرکز

رشد تجهیزات پزشکی

فهرست عنوان‌ها

۲ _____ معرفی محصول دستگاه زدایش عمودی عمیق با یون فعال

۲ _____ معرفی محصول

۳ _____ مشخصات فنی محصول

۴ _____ اطلاعات شرکت

معرفی محصول دستگاه زدایش عمودی عمیق با یون فعال

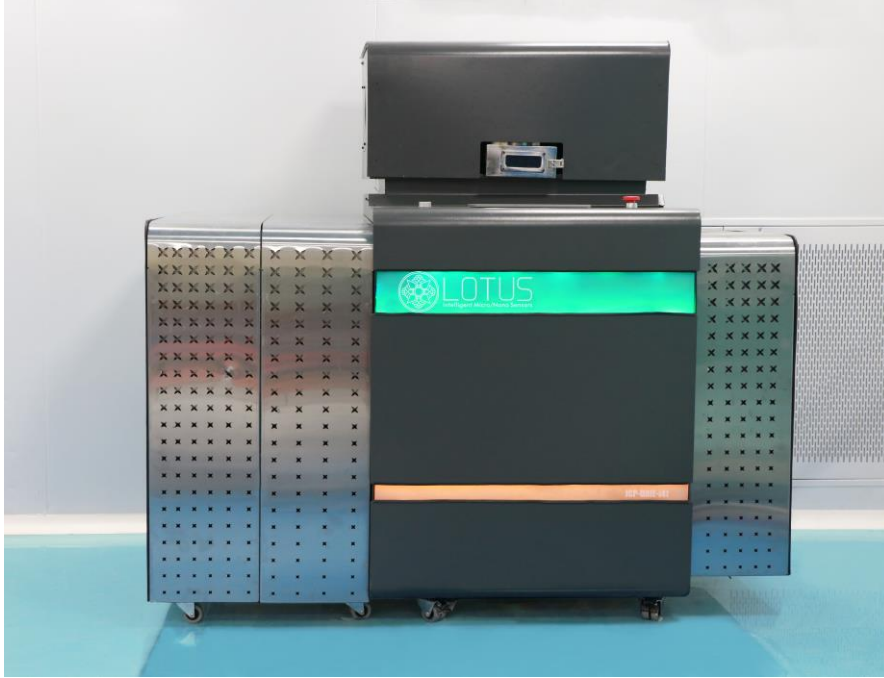
معرفی محصول

در ساخت افزاره‌های نیمه‌هادی داشتن دستگاه‌هایی که قابلیت زدایش ویفر سیلیکونی را داشته باشند از اهمیت بالایی برخوردار است یکی از این تجهیزات دستگاه زدایش عمودی عمیق با یون فعال (Deep Reactive Ion Etching) می‌باشد. این دستگاه توانایی زدایش ناهمسانگرد ویفرهای سیلیکونی را دارد همچنین نرخ زدایش این روش نسبت به روش‌های دیگر بیشتر می‌باشد.

فناوری/محصول ساخته شده و خصوصیات عملکردی شاخص آن

از ویژگی‌های شاخص دستگاه زدایش عمودی عمیق با یون فعال:

- زدایش ویفرهای ۲،۳ و ۴ اینچ
- نرخ زدایش بالا نسبت به دستگاه‌های داخلی
- دارای سیستم پمپینگ توربو
- دارای سیستم ICP
- دارای سیستم خنک کننده بستر
- قابلیت زدایش عمودی عمیق (Vertical Etching)



مشخصات فنی محصول

Plasma Source	Specially Designed Module for High Density Plasma
Sample Size	2", 3", 4" wafers
Source (ICP) Power	RF~ 1000W
Bias Power	RF bias: 13.56 MHz, up to 600 W
High Vacuum Pumping System	TMP + Mechanical Rotary Pump'

Ultimate Pressure	$<5 \times 10^{-5}$ Torr within 1 hour
-------------------	--

اطلاعات شرکت

نانوحسگرهای هوشمند لوتوس

تهران - بزرگراه چمران - خیابان باقرخان - مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) - مرکز رشد تجهیزات پزشکی

تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۰۲۳۰۸

نمابر: info@imns.ir

